



一种可控制备单层和少层硫化钼的方法

文献类型: 专利

...

作者 包信和; 邓澆; 邓德会

发表日期 2015-11-01

专利国别 CN

专利号 CN201310676237.7

专利类型 发明

权利人 中国科学院大连化学物理研究所

是否PCT专利 否

中文摘要 本发明公开了一种可控制备单层和少层硫化钼的方法。具体地说,该方法是一种基于溶剂热的方法,利用钼基化合物的水溶液与含硫化合物在低温下直接反应生成目标产物。所制备的硫化钼具有规整的二维层状结构,且层数为单层或少层。本方法具有简单,易于操作和控制的特点。

学科主题 物理化学

公开日期 2015-06-17

授权日期 2015-11-01

申请日期 2013-12-11

语种 中文

专利申请号 CN201310676237.7

源URL [http://cas-ir.dicp.ac.cn/handle/321008/144895]

专题 大连化学物理研究所_中国科学院大连化学物理研究所

作者单位 中国科学院大连化学物理研究所

推荐引用方式 包信和,邓澆,邓德会. 一种可控制备单层和少层硫化钼的方法,一种可控制备单层和少层硫化钼的方法,一种可控制备单层和少层硫化钼的方法,一种可控制备单层和少层硫化钼的方法. CN201310676237.7. 2015-11-01.
GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [大连化学物理研究所](#)

浏览

193

下载

0

收藏

0

其他版本

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。